

Lekcia 1

Mikroobrábanie

Súčasný stav technológií v elektronike

Mikroobrábanie / *microfabrication*

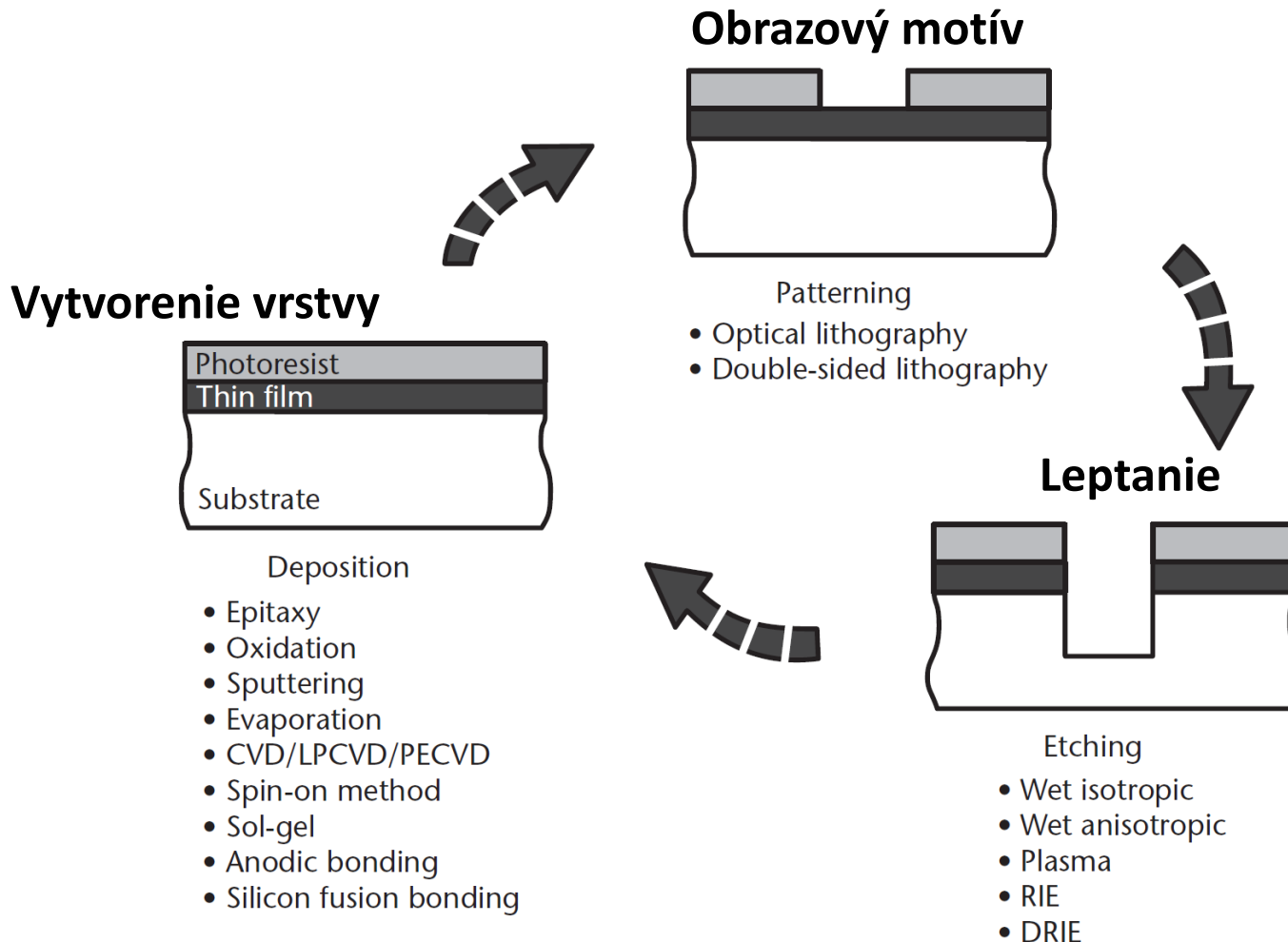
Typické rozmery $(0,1-100 \mu\text{m})^{\text{horiz}} \times (10 \text{ nm}-1 \mu\text{m})^{\text{vert}}$

Mikrotechnológie:

Elektróny v polovodičoch	+	mikro- obrábanie	→ Mikroelektronika
Fotóny v polovodičoch	+		→ Optoelektronika
Prístroje	+		→ Mikrosenzory
Chémia a biotechnológie	+		→ Mikrofluidika
Optika	+		→ Mikro-optika
Kvantová mechanika	+		→ Nanotechnológie
Robotika/mechatronika	+		→ MEMS, NEMS

Základné procesy mikroobrábania

vid'. F3370



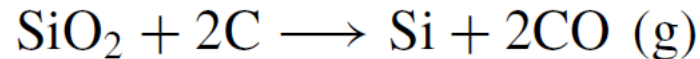
Základný vývojový diagram procesov pri mikroobrábaní: Prebehne depozícia vrstiev; Na fotorezist sa litograficky vytvorí motív ktorý slúži ako maska pri leptaní podkladového materiálu. Proces sa opakuje až kým nedôjde k dokončeniu požadovanej mikroštruktúry.

Kremík Si – (*silicon*)

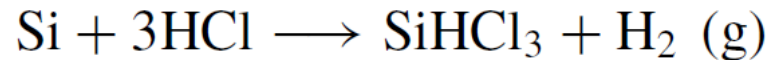
- Základný materiál v elektronike, ktorý na začiatku 60-tych rokov nahradil germánium.
- Hlavné výhody:
 - Ľahko sa oxiduje, pričom **oxidová vrstva**
 - je výborný elektrický izolant a
 - vhodné selektívne vlastnosti pri difúznej úprave dopantami.
 - Obrovské prírodné zásoby (26% zloženia zemskej kôry) = nízka cena
 - Širší zakázaný pás (1,12 eV) ako Ge (0,67 eV), čo umožňuje pracovať aj pri vyšších teplotách.
 - Vďaka mechanickej pevnosti sa Si využíva aj pri senzoroch a MEMS
- Podľa potrieb využívame kremík vo forme: kryštalickej (monokryštál), polykryštalickej (napr. solárne panely) alebo amorfnej (sklo, SiO₂+ iné oxidy kovov).

Výroba čistého kremíka

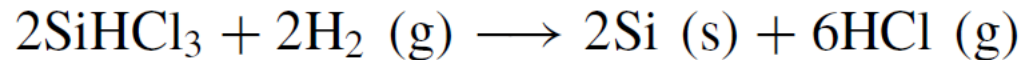
Kremenný piesok (SiO_2) sa redukuje uhlíkom, čím získame metalurgický Si s čistotou 98% (MGS - *metallurgical grade silicon*)



Prevedieme ho na plynný trichlórosilán SiHCl_3 aby sa hlavné nečistoty (Fe, B, P) premenili na zlúčeniny FeCl_3 , BCl_3 a $\text{PCl}_3/\text{PCl}_5$, ktoré je možné destilačne odstrániť.



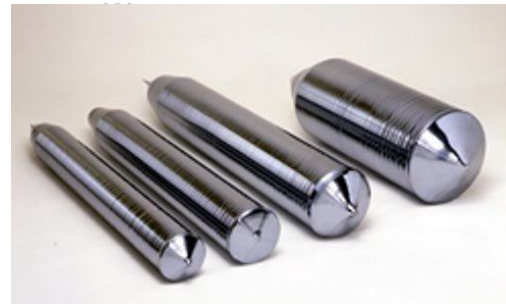
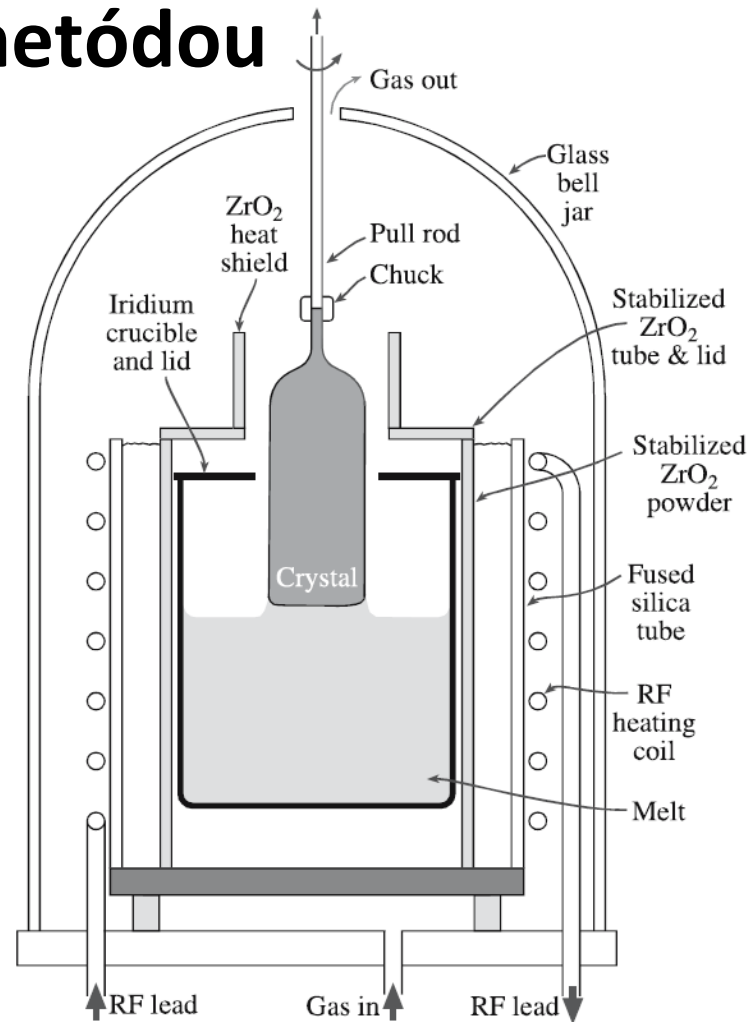
Naspäť získame kremík depozíciou na horúce kremíkové tyče:



Získame vysokočistý, polykryštalický Si, tzv. EGS – *electronic grade silicon*, vhodný pre výrobu kremíkových monokryštálov.

Rast kryštálu Czochralského metódou

- Tavný kelímok z SiO_2 naplníme EGC pri cca 1420°C roztavíme vo vákuu.
- Následne do taveniny ponoríme malý kryštál (kryštalizačné jadro, nemusí byť nutne Si) so známou kryštalickou orientáciou. Jadro pomaly vyťahujeme z taveniny. Kremík tuhne na jeho povrchu a kopíruje jeho kryštalickú štruktúru.
- Ťažný prút (ingot) aj kelímok počas procesu pomaly rotujú (20 a 10 rpm) aby minimalizovali poruchy od nerovnomerného ohrevu.
- Samotný SiO_2 kelímok je nevyhnutným zdrojom kontaminácie.
- Rýchlosti rastu sú na úrovni 1mm/min.

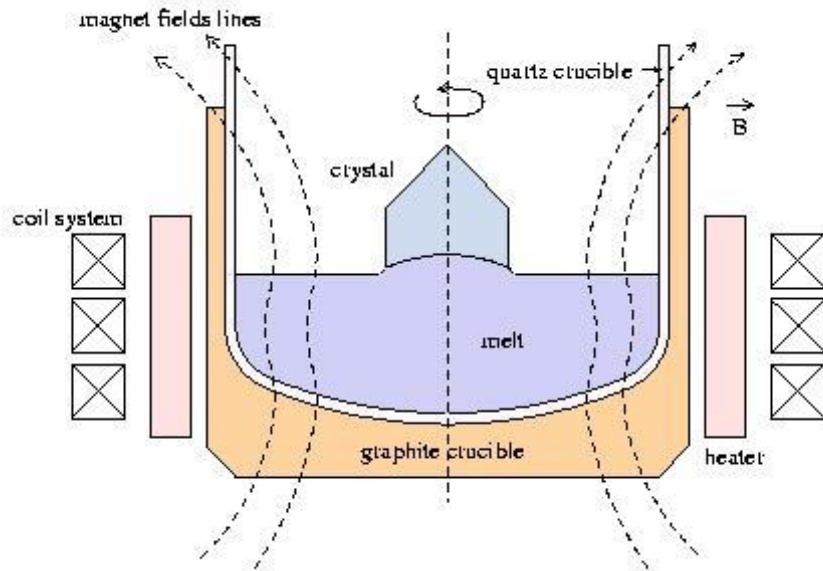


Alternatívy pre kremík

Magnetický Czochralski

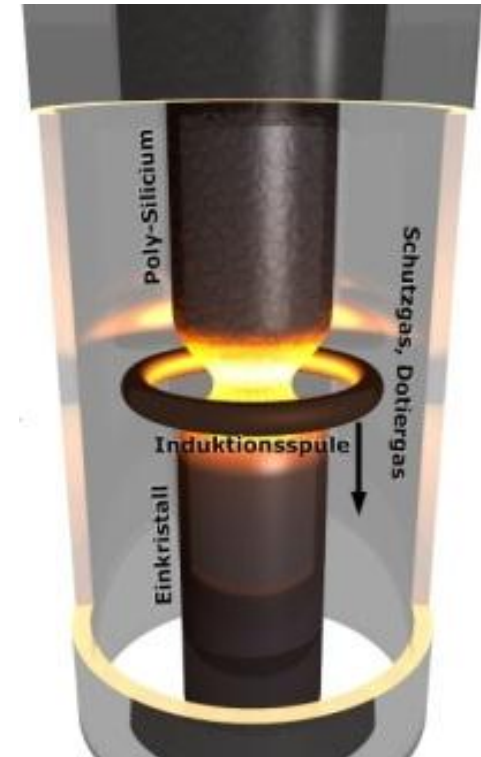
Roztavený Si je elektricky vodivý preto ho magnetické pole môže teplotne aj tokovo stabilizovať.

$$\mathbf{F} = \mathbf{j} \times \mathbf{B} = nq\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$



Metóda plávajúcej zóny / float zone

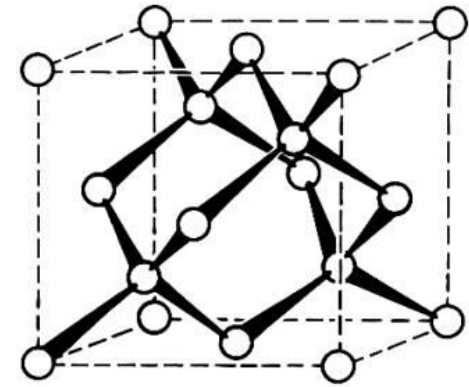
Pre extra čistý kremík sa taví len oblasť v kontakte s kryštalizačným jadrom, pričom sa polykryštalický ingot pomalu dvíha. Problém s kontamináciou od kelímka je tak odstránený.



Kryštalická štruktúra Si

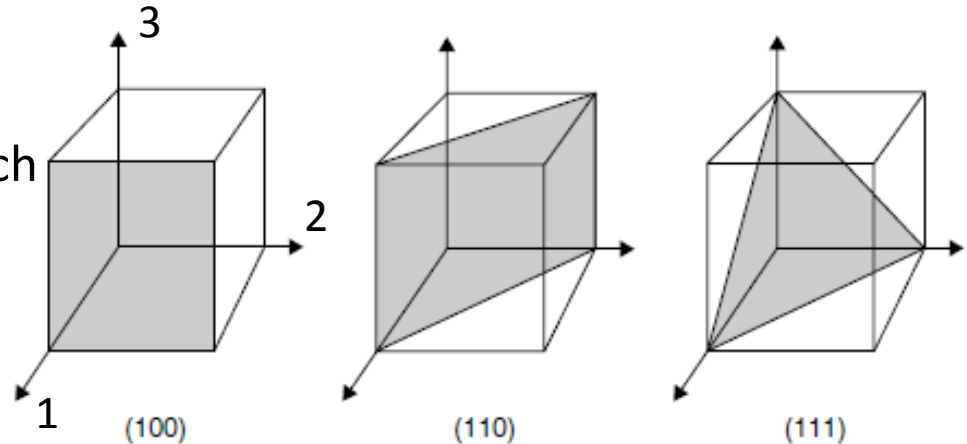
Krychlová (kubická)

„diamantová“ štruktúra. Najviac rovín súmernosti.



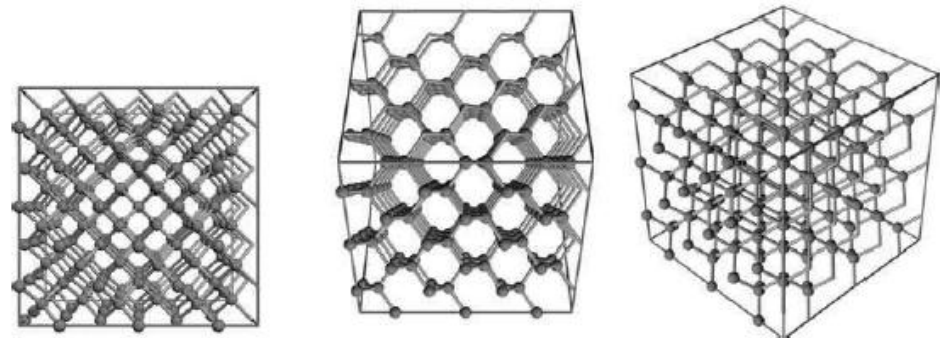
Millerove indexy definujú rovinu atómov v kryštále.

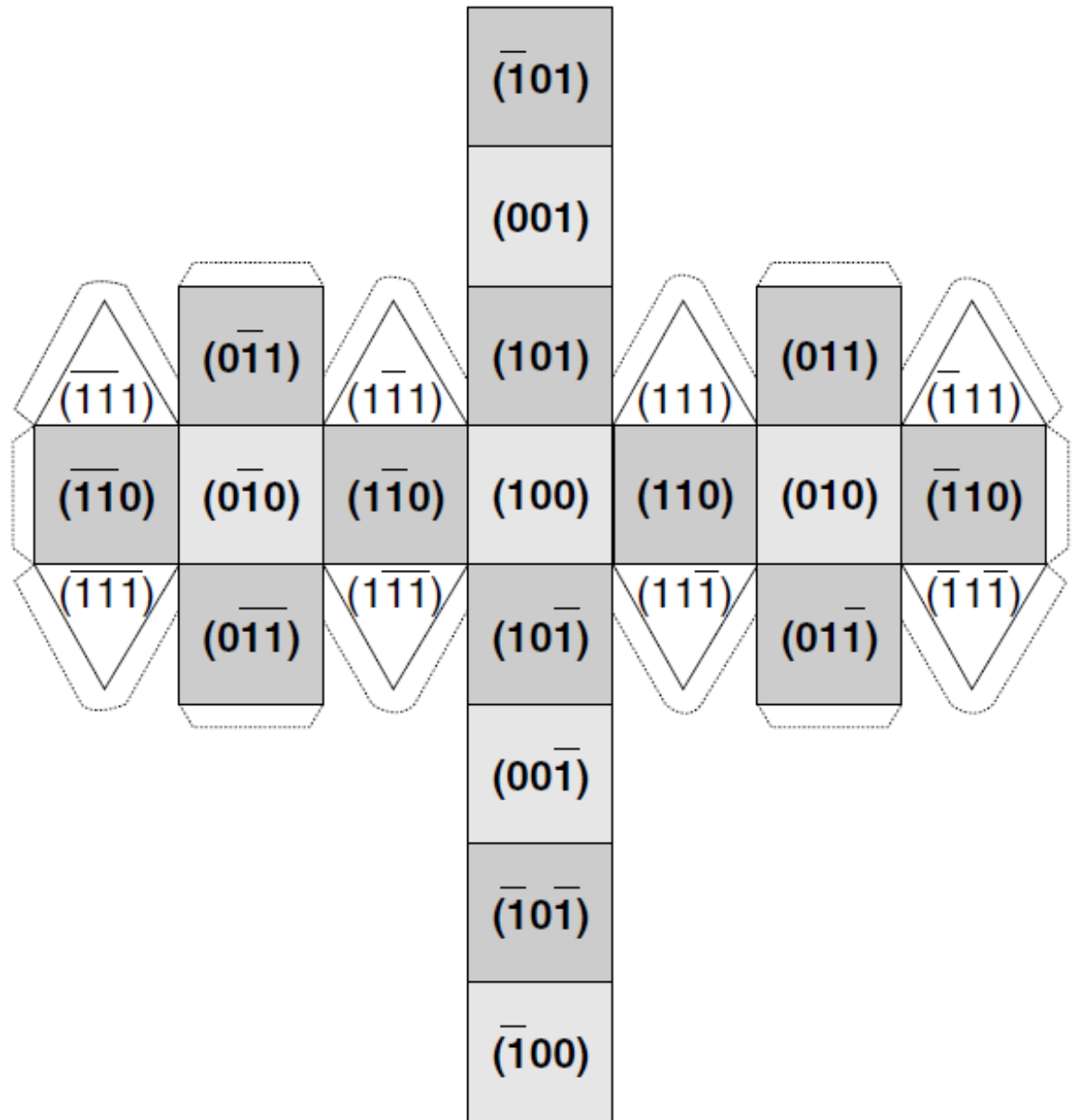
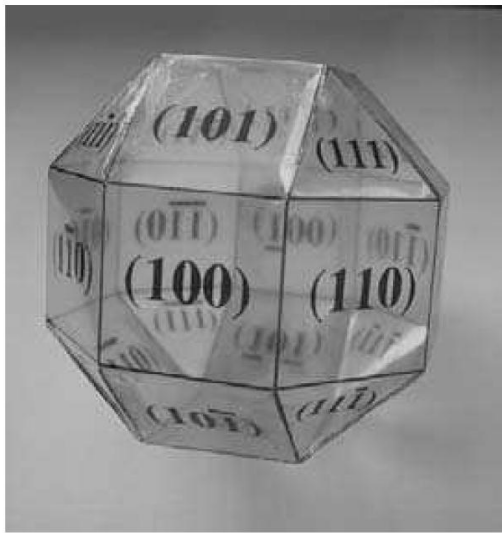
Rovina (100) pretne osi 1,2,3 v bodoch $(1, \infty, \infty)$. Millerove indexy sú prevrátené hodnoty týchto priesečníkov – teda $(1,0,0)$.



Rez danou rovinou určí, aká bude vzájomná poloha atómov Si na rozrezanom povrchu.

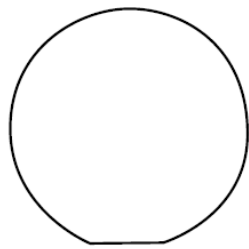
Hlavné využitie majú (100) CMOS a (111) bipolárne tranzistory.



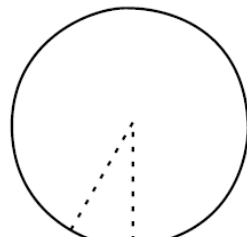


Výroba substrátov (*wafers*)

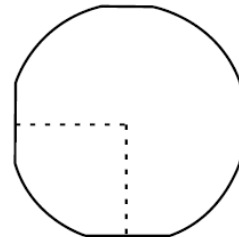
- Delenie na 50cm „polienka“ XRD kontrola kryštalickej orientácie a označenie
- Narezanie na substráty
- Dohladenie na rovinnosť, planparalelitu a zhodnú drsnosť oboch plôch (*lapping*)
- Zaoblenie hrán (proti štiepaniu a ulpievaniu vody pri sušení)
- Očistenie leptaním (KOH alebo HF-HNO₃)
- Žíhanie pri 600 až 800°C odstráni medzimriežkové kyslíkové komplexy (tzv. termálne donory)
- Finálne leštenie 10nm Si pastou v alkalickom roztoku na drsnosť 0,1-0,2 RMS (tzn. úroveň jednotlivých atómov)



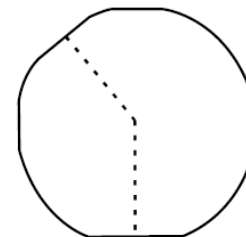
(111) p-type



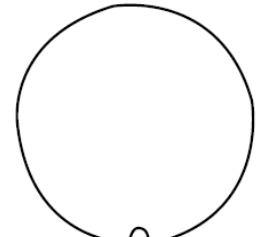
(111) n-type



(100) p-type



(100) n-type



(100) n-type

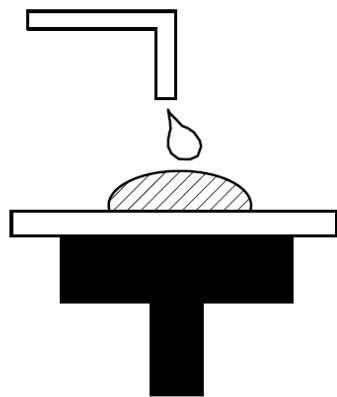
Dohodnuté značenie waferov

Vytváranie vrstiev

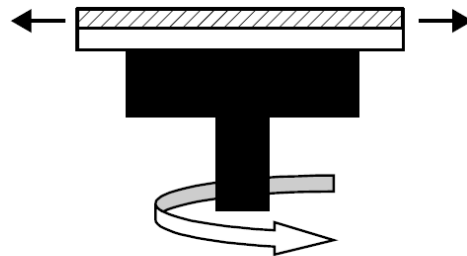
- **Hrubé vrstvy:** 10-25 μ m, vytvára sa z kvapalnej fázy
 - Spin coating
 - Dip coating
 - Sol-gel
 - Pokovenie: galvanické (*electroplating*) a bezprúdové (*electroless*)
 - Sieťotlač (sítotisk, *screenprinting*)
- **Tenké vrstvy:** menej ako 5 μ m, vytvára sa v plynnej fáze
 - CVD – *chemical vapor deposition*
 - ALD – *atomic layer deposition*
 - PECVD – *plasma enhanced CVD*
 - Naparovanie – *evaporation*
 - Naprašovanie - *sputtering*
 - Epitaxia – *epitaxy*, MBE – *molecular beam epitaxy*

Spin coating

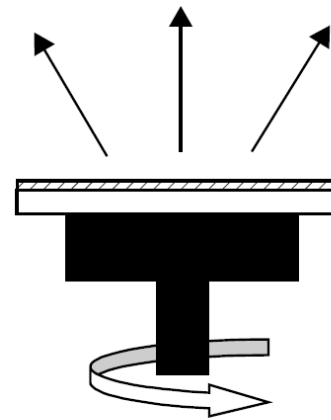
- Hlavne nanášanie polymérneho fotorezistu. Využíva odstredivú silu k radiálnemu tečeniu prchavej kvapaliny. Nutný plochý substrát.
- **Staticky:** Kvapky sa roztečú až potom sa rozkrúti disk (20 000 rpm)
- **Dymanicky:** Kvapky dopadnú na pomaly sa krútiaci disk (500 rpm), rotácia sa následne zrýchli (5 000 rpm)
- Hrúbka (tloušťka) filmu je úmerná $\omega^{-2/3}$ a $\eta^{1/3}$



Resist dispensing
(a few millilitres)



Acceleration
(resist expelled)

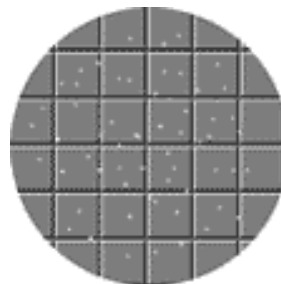
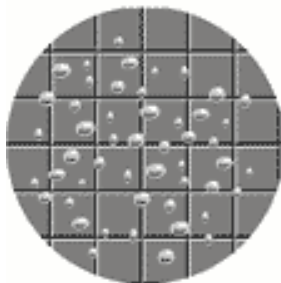


Final spinning 5000 rpm
(partial drying via evaporation)

Spin coating – možné chyby

Vzduchové bubliny

Bubliny v nanášanej kvapaline.
Zle zrezané kapátko.

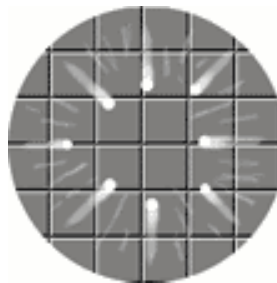
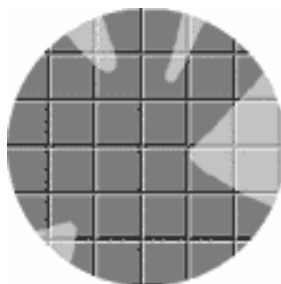


Dierky

Vzduchové bublinky.
Čiastočky v nátere.
Čiastočky na vzorke.

Plocha bez vrstvy

Malý objem kvapaliny.

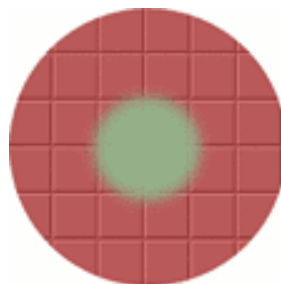
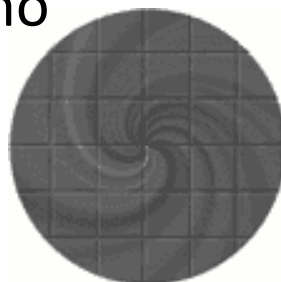


Čmuhy

Prirýchle dávkovanie.
Prisilný odťah.
Náter čaká pridlho na roztočenie.
Príliš rýchla rotácia resp. zrýchlenie.
Nečistoty na vzorke.
Kvapka mimo stred rotácia.

Vírovitý obrazec

Príliš rýchle odsávanie.
Kvapka nanesená mimo stred rotácie.
Vysoké otáčky.
Krátky čas otáčania.



Upínacia značka

Tepelná výmena náteru s kovovým upínacím systémom vzorky

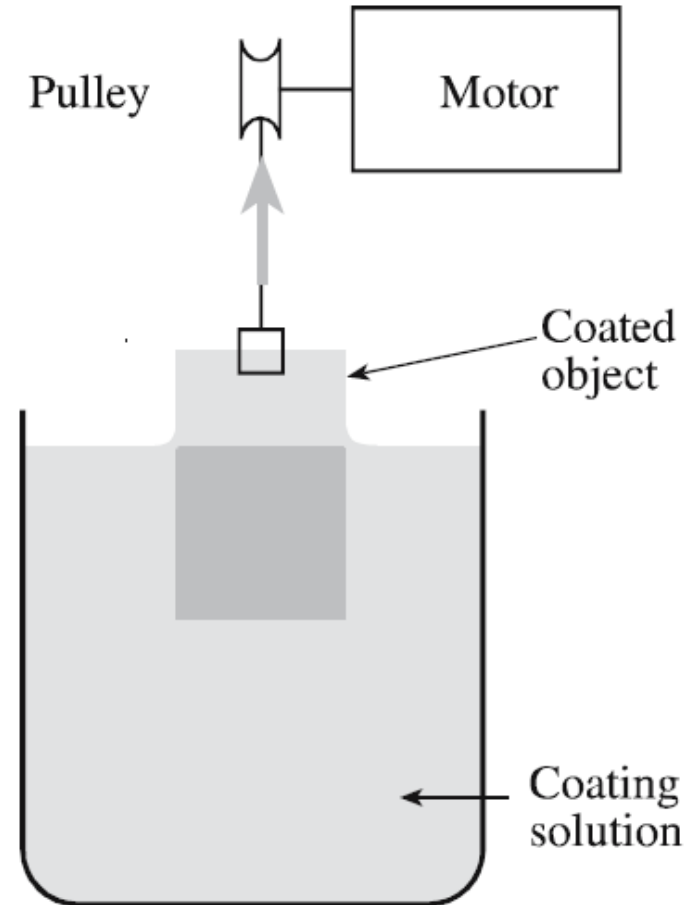
Dip coating

Obvykle na vytváranie sol-gel vrstiev pre následný výpal. Vzorka ponorená do vhodného roztoku sa z neho pomaly vyťahuje (10-30 cm/min).

Pre hrúbku t nanesej vrstvy platí (V – vyťahovacia rýchlosť):

$$t = 0.944 \left(\frac{\eta V}{\gamma_{lv}} \right)^{1/6} \left(\frac{\eta V}{\rho g} \right)^{1/2}$$

<i>Film use</i>	<i>Composition</i>
Mechanical protection	SiO ₂
Chemical protection	SiO ₂
Transparent electrode	In ₂ O ₃ -SnO ₂
Antireflecting	Na ₂ O-B ₂ O ₃ -SiO ₂
Specific absorption	TiO ₂ -SiO ₂ Cr ₂ O ₃ -SiO ₂ Fe ₂ O ₃ -SiO ₂
Catalytic	
Photo mode	TiO ₂
Ionic mode	β-Al ₂ O ₃ Ta ₂ O ₅



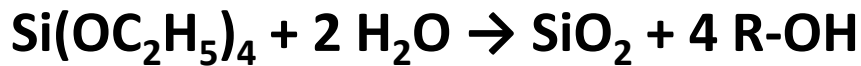
Sol-gel

Sol – koloidná suspenzia malých (1-1000nm) častíc v kvapaline

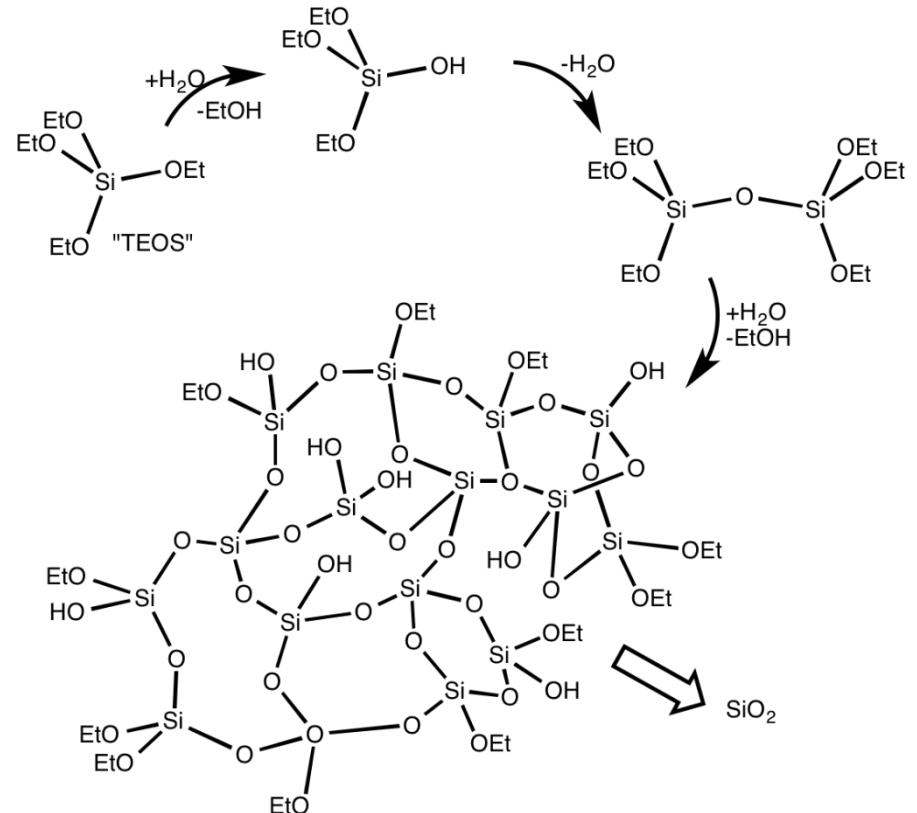
Gel – porézna trojrozmerná sieť, ktorá vznikne v kvapalnej suspenzii. Kvapalina sa následne vysuší a prípadne kalcinuje pri vysokej teplote.

Typický sol-gel proces používa alkoxid kovu $M-(O-R)_n$ v organickom rozpúšťadle ($R = \text{alkyl} = C_nH_{2n+1}$), ktorý ochotne reaguje s vodou a následná hydrolýza vytvorí 3D sieť.

Príklad: SiO_2 sol-gel vrstva:

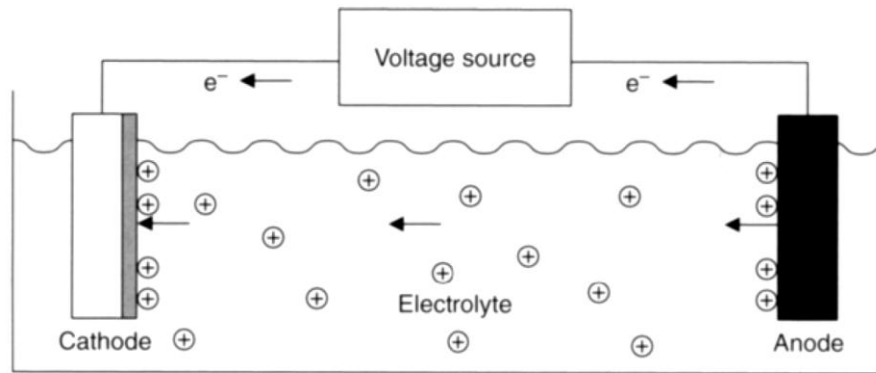


$Si(OC_2H_5)_4$ - TEOS tetraetoxysilán



Pokovenie – galvanické (princíp)

- Vodivá vzorka, ponorená do elektrolytu s požadovaným kovovými iónmi, sa pripojí ako katóda (mínus) ku zdroju elektrického napätia. Protielektróda je buď pasívna (napr. platinová), alebo je vyrobená z kovu ktorý sa snažíme deponovať. Rýchlosti 0,1-10 $\mu\text{m}/\text{min}$.



- Katióny kovu sa na elektróde (katóde) redukujú (zneutralizujú) a usadia na povrchu.

Med': $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu (s)}$ elektrolyt: roztok CuSO_4

Zlato: 1.krok $\text{Au(CN)}_2^- \leftarrow \rightarrow \text{AuCN} + \text{CN}^-$ elektrolyt na báze:

2.krok $\text{AuCN} + \text{e}^- \rightarrow \text{Au(s)} + \text{CN}^-$

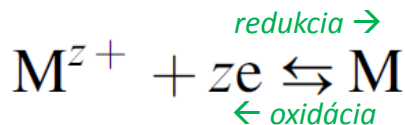
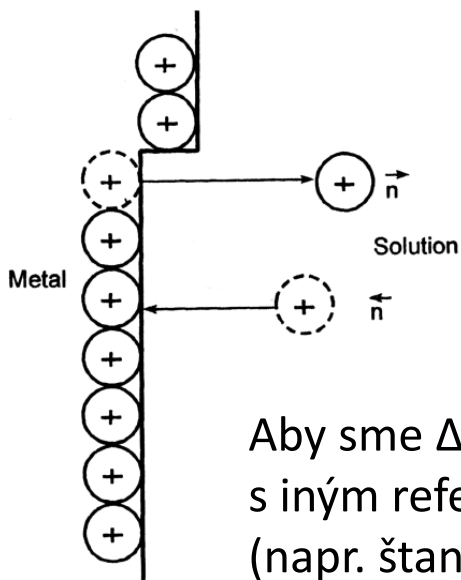
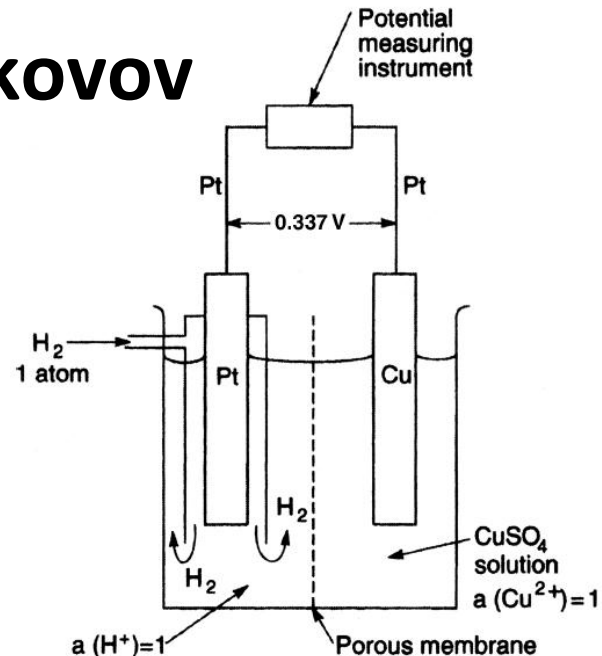
KAu(CN)_2

dikyanozlatnan draselný

Štandardný redukčný potenciál kovov

Kov je mriežka katiónov medzi ktorými sa pohybuje elektrónový plyn.

Ak vložíme kov **M** do roztoku, ktorý obsahuje jeho ióny M^{z+} (napr. roztok soli daného kovu), ióny z kovovej mriežky budú unikať do roztoku a naopak, kým nenastane dynamická rovnováha, s rozdielom elektrického potenciál $\Delta\phi$:



$$\Delta\phi = \phi_{\text{metal}} - \phi_{\text{solution}}$$

Aby sme $\Delta\phi$ zmerali, spojíme ju s iným referenčným systémom (napr. štand. vodíková elektroda).

TABLE 1.1 Standard Electrode Potentials

Metal/Metal Ion Couple	Electrode Reaction	Standard Value (V)
Au/Au ⁺	Au ⁺ + e ⇌ Au	1.692
Au/Au ³⁺	Au ³⁺ + 3e ⇌ Au	1.498
Pd/Pd ²⁺	Pd ²⁺ + 2e ⇌ Pd	0.951
Cu/Cu ⁺	Cu ⁺ + e ⇌ Cu	0.521
Cu/Cu ²⁺	Cu ²⁺ + 2e ⇌ Cu	0.3419
Fe/Fe ³⁺	Fe ³⁺ + 3e ⇌ Fe	-0.037
Pb/Pb ²⁺	Pb ²⁺ + 2e ⇌ Pb	-0.1262
Ni/Ni ²⁺	Ni ²⁺ + 2e ⇌ Ni	-0.257
Co/Co ²⁺	Co ²⁺ + 2e ⇌ Co	-0.28
Fe/Fe ²⁺	Fe ²⁺ + 2e ⇌ Fe	-0.447
Zn/Zn ²⁺	Zn ²⁺ + 2e ⇌ Zn	-0.7618
Al/Al ³⁺	Al ³⁺ + 3e ⇌ Al	-1.662
Na/Na ⁺	Na ⁺ + e ⇌ Na	-2.71

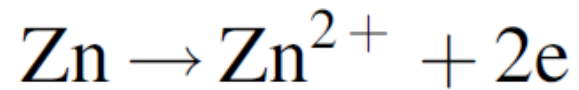
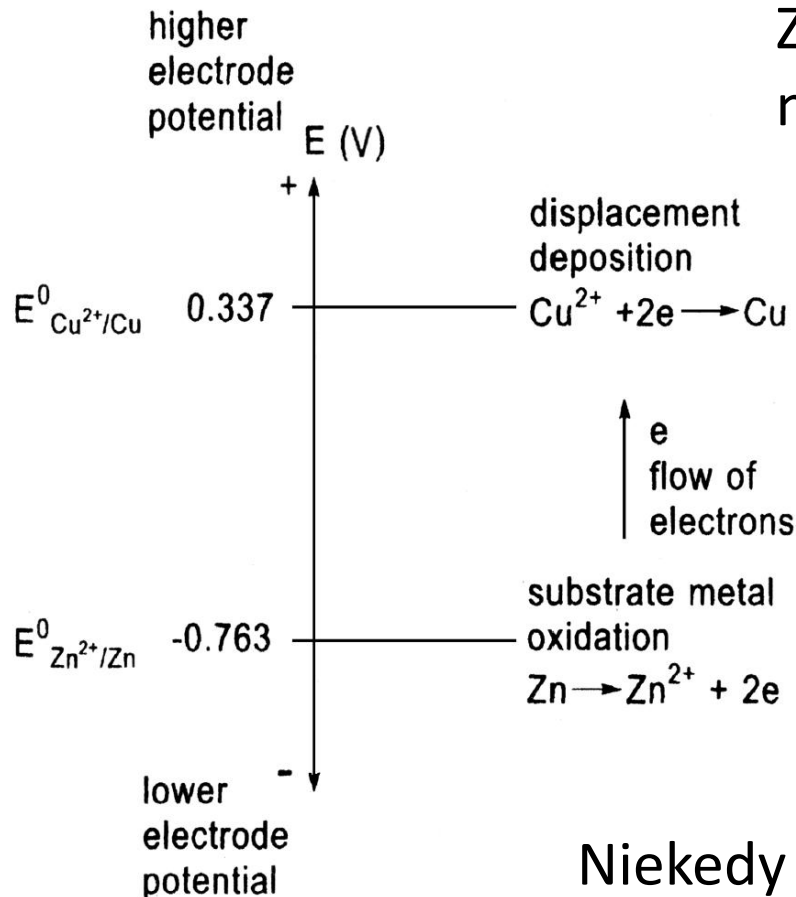
Nadbytok M⁺ v kove

Nadbytok M⁺ v roztoku

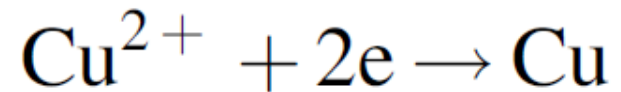
Spontánne vylučovanie kovových povlakov /*displacement deposition*

- Štandardný redučný potenciál kovov vysvetľuje, prečo sa na Zn ponorenom do vodného roztoku CuSO_4 spontánne vytvorí vrstva medi.

Zinok sa začne uvoľňovať do roztoku a nechá k kove e^-



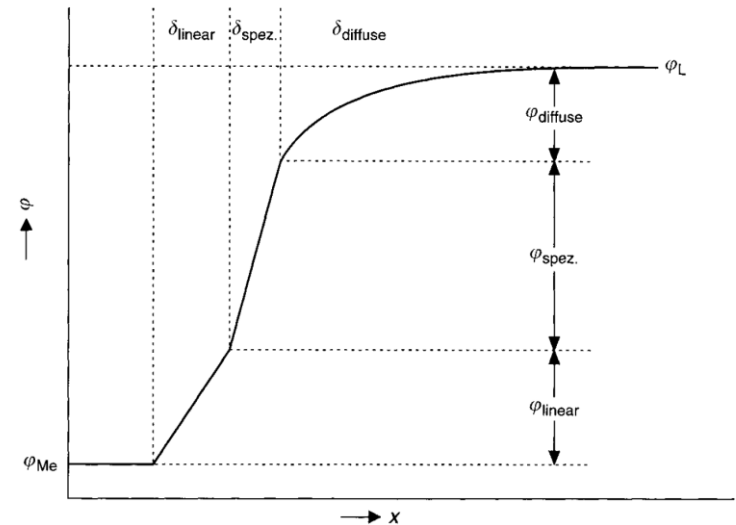
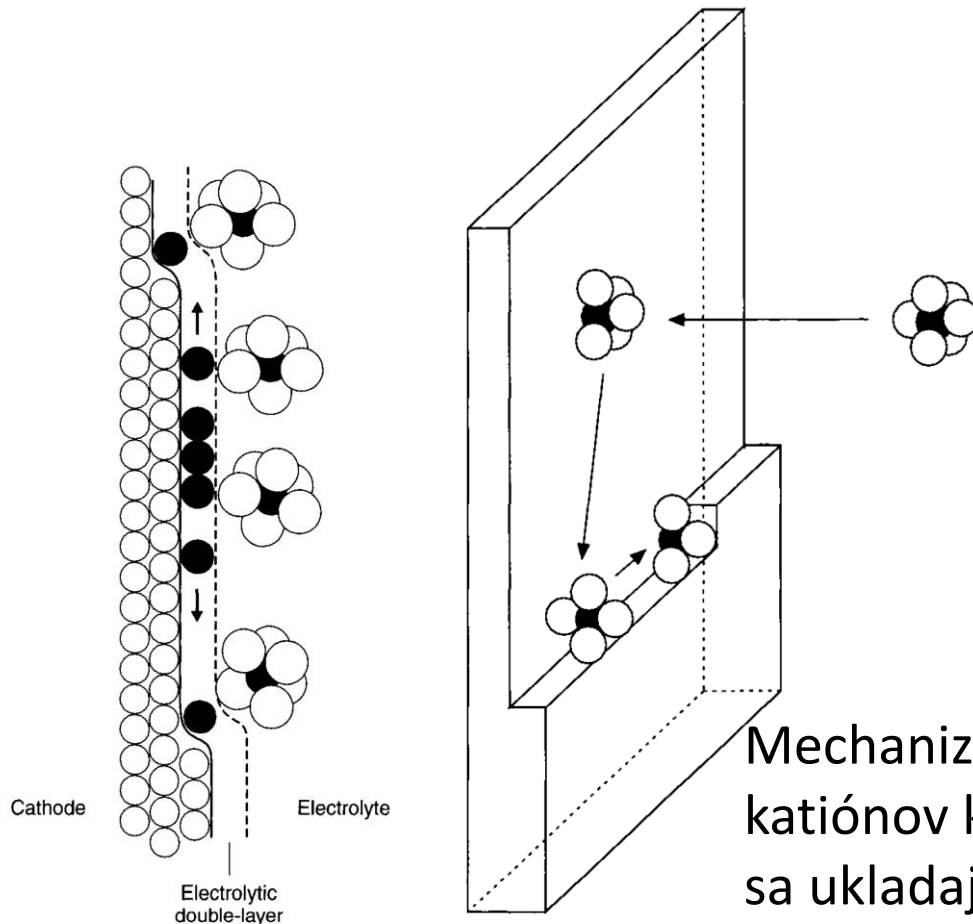
Meď využije voľné e^- aby sa redukovala na kove.



Niekedy hovoríme, že meď je „vzácnejšia“ ako zinok, preto sa naň spontánne deponuje.

Molekulárny pohľad

Pripojenie kovu v externému poľu zmení $\Delta\phi$ na rozhraní a tak urýchli (prípadne umožní) depozíciu.

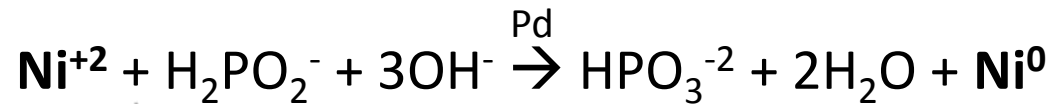
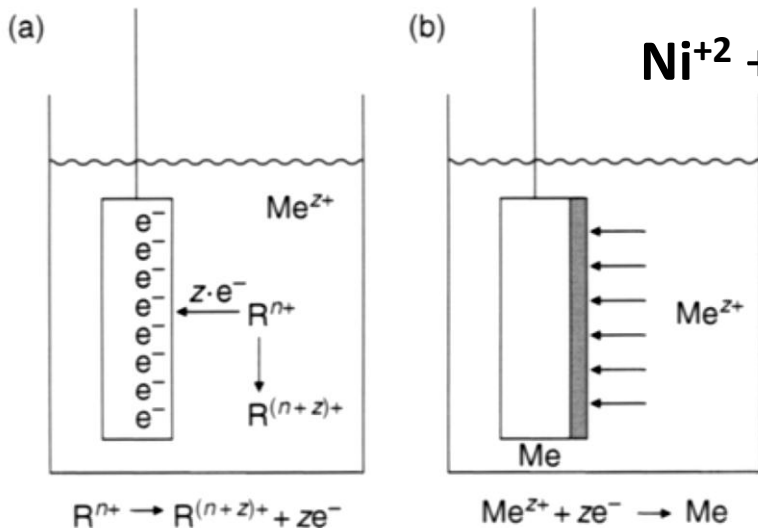
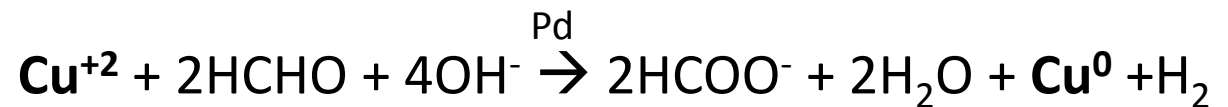


Stern-Grahamov model nenarušeného $\Delta\phi$ na rozhraní (tzv. elektrická dvojvrstva)

Mechanizmus ukladania hydratovaných katiónov kovov na povrch katódy. Preferenčne sa ukladajú na miesta dislokácií kryštalickej mriežky.

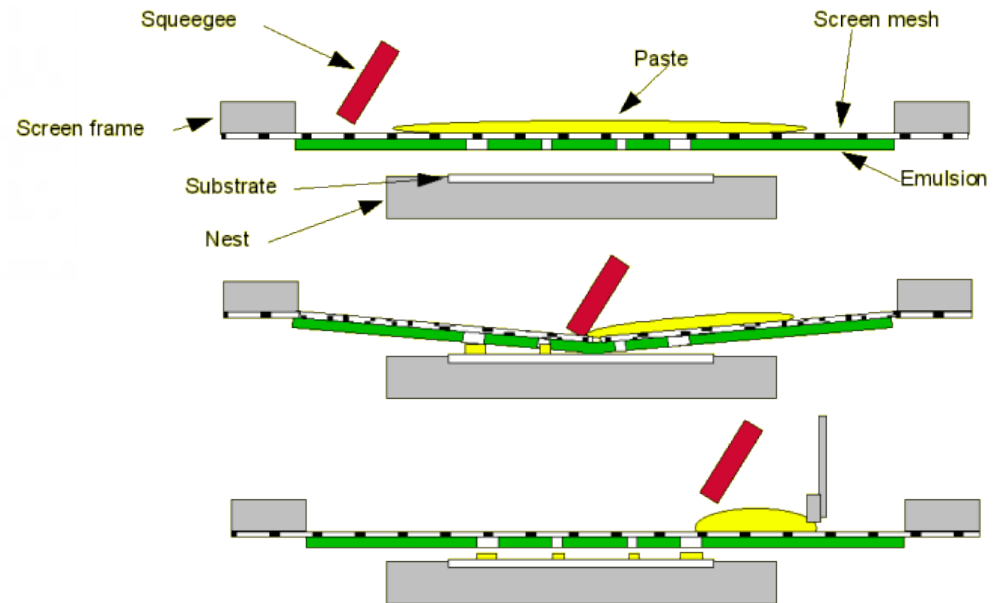
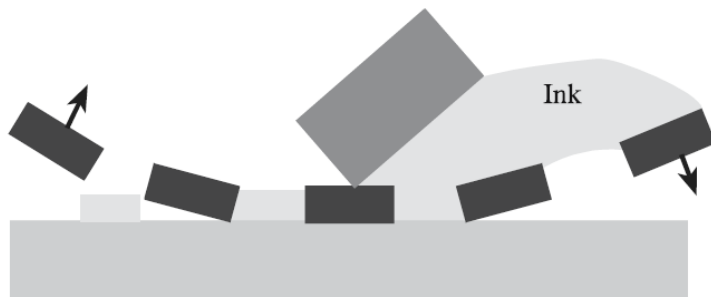
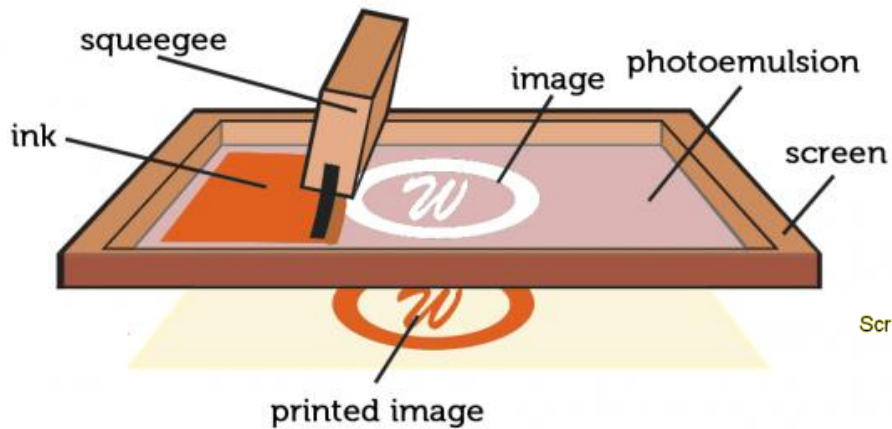
Bezprúdové (chemické) pokovenie / *electroless*

- Umožní pokoviť elektricky nevodivé povrchy. V elektronike hlavne pokovenie otvorov v plošných obvodoch. Rýchlosť 0,1 μm/min.
- **1. krok** – redukovanie katalyzátora na povrchu, zvyčajne paládium Pd, napríklad z SnCl₂/PdCl₂: $\text{Pd}^{2+} + \text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn}^{4+} + \text{Pd}^0$
- **2. krok** – adsorbované Pd odoberie elektrón redukčnému činidlu R (formaldehyd, NaH₂PO₂ ...) tento elektrón je následne schopný redukovať kov (Cu²⁺, Ni²⁺) z elektrolytu, ktorá potom už pokračuje samostatne (autokatalyticky)



Sieťotlač, sítotisk / *screen printing*

- Čína 1000 p.n.l. Pasta sa pomocou gumovej stierky pretlačí cez jemné sito na potlačovaný substrát. Prenesie sa tak obrazec na site. Vhodné pre rozlíšenie až do $5 \times 5 \mu\text{m}$. Napr. pre cíňovanie dosky plošného spoja pre SMD súčiastky.



Literatúra

Sami Fransilla: *Introduction to Microfabrication*, Wiley; 2nd Edition 2010

Carter C. Barry, Norton M. Grant: *Ceramic materials/Science and Engineering*, Springer 2007

Nasser Kanani: *Electroplating, Basic Principles, Processes and Practice*, Elsevier 2004